PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-099345

(43)Date of publication of application: 11.04.1995

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 23/29

H01L 23/31

(21)Application number: **05-241449**

(71)Applicant:

NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

28.09.1993

(72)Inventor:

MATOBA KOSUKE

KISHI AKITO

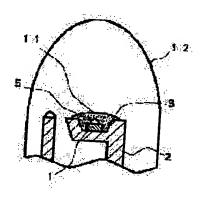
NAKAMURA SHUJI

(54) LIGHT EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a LED capable of avoiding color mixture even if the LEDs in different wavelength are closely arranged when a fluorescent pigment is used while the focussing of converted and emitted light is enhanced for increasing the brightness of the LED when a wavelength conversion material is contained in a resin of LED for wavelength conversion

CONSTITUTION: A sealing resin of LED comprises the first resin 11 filling up the inside of a cup 3 and the second resin 12 encircling the first resin 11 while the first resin 11 contains the fluorescent material converting the light emitting wavelength of a light emitting chip to the other wavelength or a wavelength converting material 5 such as a filter material, etc., partly absorbing the light emitting wavelength thereby increasing the brightness, focussing efficiency due to the wavelength conversion light reflected on the



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.04.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

application converted

[Date of final disposal for application]

14.04.1997

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention] this invention is changed into the wavelength which is applied to light emitting diode (henceforth Light Emitting Diode), especially is different in the photogenesis wavelength of a photogenesis chip, or relates to Light Emitting Diode which absorbs a part of photogenesis of a photogenesis chip.

[Description of the Prior Art] The cup prepared in order to reflect in a leadframe the photogenesis chip with which drawing 2 is a type-section view showing one structure of the conventional Light Emitting Diode, and 1 consists of a compound semiconductor, and 2 and for 3 to reflect photogenesis of a photogenesis chip in a photogenesis observation side side, and 4 are resins which close the whole light emitting device. Usually, although a highly transparent resin is chosen in order for a resin 4 to emit photogenesis of a photogenesis chip efficiently into air The fluorescent substance which changes photogenesis of a photogenesis chip into other wavelength into the resin 4 in order to be the purpose which changes the luminescent color of the photogenesis chip into others or to rectify a color, or VCF matter 5 (it is hereafter called the wavelength conversion material 5.) which absorbs a part of photogenesis wavelength of photogenesis wavelength It may be mixed. In this case, usually it is mixed so that the wavelength conversion material 5 may be uniformly distributed to a resin 4. [0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, when the wavelength conversion material 5 is uniformly distributed in a resin 4 for the above-mentioned purpose, as shown in this drawing, the light by which wavelength conversion was carried out, or the light into which unnecessary wavelength was cut are scattered about in all directions in a resin 4, and have the problem that condensing becomes bad. The arrow head of drawing 2 is drawing shown typically a mode that the light by which wavelength conversion of the light of a photogenesis chip was carried out in the wavelength conversion material 5 was scattered about. That is, when the light by which wavelength conversion was carried out is scattered about, the quantity of light by the side of a photogenesis-observation-side decreases, and brightness becomes low.

[0004] Moreover, when the wavelength conversion material 5 is limited to a fluorescent substance, it approaches and Light Emitting Diode of the different luminescent color is installed as a new trouble, there is a problem of excessive photogenesis of the fluorescent substance by other Light Emitting Diode photogenesis. For example, green Light Emitting Diode containing the fluorescent substance from which green photogenesis is obtained with a blue photogenesis chip, If green Light Emitting Diode is switched off and blue Light Emitting Diode is turned on when it approaches horizontally on the same flat surface and blue Light Emitting Diode which consists only of a mere blue photogenesis chip is put in order, by the light which leaks and comes out of blue Light Emitting Diode, i.e., the scattered-about light The fluorescent substance of green Light Emitting Diode is excited, it will be in the status that green Light Emitting Diode which put out the light lit up, and the color mixture of both Light Emitting Diodes occurs.

[0005] Therefore, the place made into the purpose of this invention sets it as another purpose to offer Light Emitting Diode to which color mixture does not happen even if it approaches and it installs Light Emitting Diode from which wavelength is different, when a fluorescent pigment is used [and] for the purpose of improving condensing of the photogenesis changed first and raising the brightness of Light Emitting Diode in case the resin of Light Emitting Diode is made to contain a wavelength conversion material and wavelength conversion of a photogenesis chip is performed. [0006]

[Means for Solving the Problem] The first resin with which Light Emitting Diode of this invention is Light Emitting Diode which comes to close the whole light emitting device by which the photogenesis chip was laid in the pars basilaris ossis occipitalis of the cup which reflects photogenesis of a photogenesis chip in a photogenesis observation side side by the resin, and the aforementioned resin is filled up with the aforementioned interior of a cup, It consists of the second resin which surrounds the first resin, and is characterized by the fluorescent substance which changes the photogenesis wavelength of a photogenesis chip into the first aforementioned resin at other wavelength, or the VCF matter which absorbs a part of photogenesis wavelength of a photogenesis chip containing. [0007]

[Function] Light Emitting Diode of this invention absorbs a part of conversion or unnecessary wavelength for photogenesis of a photogenesis chip on desired wavelength in the first resin. Thus, although the light by which wavelength conversion was carried out is scattered about in all directions, it is reflected by the cup and most scattered light is condensed at a photogenesis observation side side. that is, since the cup of this application reflects the light in which wavelength conversion was carried out by the wavelength conversion material and can be condensed within the first resin, the condensing luminous efficacy of conversion light is markedly alike, and improves

[0008] Furthermore, if it is filled up with the first resin containing a fluorescent substance so that it may become lower than the level surface of the pars marginalis of a cup when a wavelength conversion material is used as a fluorescent substance, the light which carries out incidence from the exterior is interrupted on the edge of a cup, and the color mixture between Light Emitting Diodes can be prevented by not reaching even a fluorescent substance. If it says simply, when the first resin which makes a cup depth deep and contains a fluorescent substance is made not to overflow a cup, the source of excitation of a fluorescent substance can be restricted only to the photogenesis wavelength of a photogenesis chip.

[Example] Drawing 1 is a type-section view showing the structure of Light Emitting Diode of one example of this application, and is made into the structure which closed the whole light emitting device which laid the photogenesis chip 1 which consists of a compound semiconductor like drawing 2 on the leadframe 2 which has a cup 3 by the resin. However, the place different from drawing 2 consists of the first resin 11 with which a closure resin is filled up with the cup 3 interior, and the second resin 12 which surrounds the first resin, and conversion or the wavelength conversion material 5 which is absorbed in part and to change contains the photogenesis wavelength of a photogenesis chip to the first resin 11 at other wavelength.

[0010] The same material is sufficient as the material of the first resin 11 and the second resin, for example, it constitutes both from an epoxy resin, and should just make only the first resin contain a fluorescent substance 5 in Light Emitting Diode of this invention. Furthermore, the material of the second resin 12 cannot be overemphasized by that the resin 4 and identity of drawing 2 are sufficient. Moreover, as long as the wavelength conversion material 5 is a material which can change the photogenesis

wavelength of photogenesis chips, such as a fluorescent dye, a fluorescent pigment, and a fluorescent substance, into other wavelength if it is a fluorescent substance, it may use what thing, and if it is the VCF matter, the unnecessary wavelength of photogenesis of a photogenesis chip will be absorbed, the material which improves color purity is chosen, and inorganic [which usually has the same color as the luminescent color of a photogenesis chip], and an organic VCF pigment are [0011] Although it is the purpose which usually drives out the air of a cup 3 in Light Emitting Diode manufacturing process and the interior of a cup in which the photogenesis chip 1 was laid beforehand is pre dipped by the resin in order to obtain Light Emitting Diode of such structure In case it pre dips, the first resin 11 is made to contain the wavelength conversion material 5, and after the first resin 11 containing the wavelength conversion material 5 hardens, it can obtain by closing by the second resin 12. Moreover, you may pour into the cup 3 interior the first resin 11 which contains the wavelength conversion material 5 beforehand thus, the interior of 3 of a cup is filled up with the first resin 11 containing the wavelength conversion material 5, most light by which wavelength conversion was carried out by the first resin 11 returns in the reflecting mirror of a cup 3, and by reflecting in a photogenesis observation side, condensing of Light Emitting Diode is markedly alike, and improves [0012] Moreover, the external quantum efficiency of the light by which wavelength conversion was carried out improves by setting up so that the first resin 11 and second resin 12 may be made into a different material, the refractive index of the first resin 11 and the second resin 12 may be made small in order and it may become the refractive index 1 of air closely. In addition, selecting a parvus material from the refractive index of the photogenesis chip 1 into the material of the first resin 11 in this case

[0013] The drawing 3 and the drawing 4 are type-section views expanding and showing the fraction of the cup 3 of Light Emitting Diode concerning other examples of this invention, and the status that the front face of the first resin 11 becomes convex, hardened and filled up are shown. Also in which status, since it fills up so that the first resin 11 containing the fluorescent substance may become lower than the level surface of the pars marginalis of a cup 3 and a cup 3 is not overflowed when the wavelength conversion material 5 is used as a fluorescent substance, the external light which excites a fluorescent substance by [0014]

[Effect of the Invention] Since conversion light reflects inside a cup since Light Emitting Diode of this invention has filled up the interior of a cup with the first resin containing a wavelength conversion material as explained above, and it is condensed, brightness improves more than twice. Moreover, when the first resin is made to contain a fluorescent pigment, wavelength conversion is performed, a cup depth is made deep, the color mixture between Light Emitting Diodes does not occur when the first resin is made not to overflow a cup, for example, a flat-surface display is realized by Light Emitting Diode, the picture image with very sufficient resolution can be acquired.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平7-99345

(43)公開日 平成7年(1995)4月11日

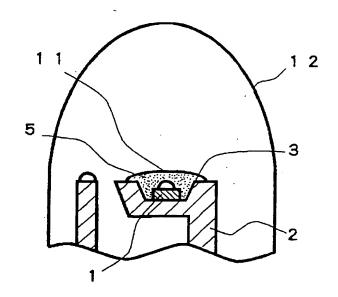
(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 L 33/00	識別記号 庁内整理番号 N A		FΙ		技術表示箇門	
	н	8617-4M 8617-4M 審查請求	H01L	23/ 30	B C	
			未請求 請求事	町の数2 OL	_	最終質に続く
(21)出願番号	特願平5-241449		(71)出顧人	000226057 日亜化学工業	#±->A¥	
(22)出顧日	平成5年(1993)9月28日		(72)発明者	徳島県阿南市 的場 功祐	「上中町岡491番 「上中町岡491番	
			(72)発明者	岸 明人	上中町岡491番	地100 日亜化
			(72)発明者	中村 修二	上中町岡491番	地100 日亜化

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード

(37)【要約】

【目的】 LEDの樹脂に波長変換材料を含有させて発 光チップの波長変換を行う際、まず変換された発光の集 光をよくしてLEDの輝度を高めることを目的とし、ま た蛍光顔料を使用した際、波長の異なるLEDを近接し て設置しても混色の起こらないLEDを提供する。

【構成】 LEDの封止樹脂が、カップ3内部を充填する第一の樹脂11と、その第一の樹脂を包囲する第二の樹脂12とからなり、第一の樹脂11には発光チップの発光波長を他の波長に変換する蛍光物質、または発光波長を一部吸収するフィルター物質等の波長変換材料5が含有されていることにより、波長変換光がカップ3に反射されるため輝度、集光効率が向上する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光チップの発光を発光観測面側に反射 するカップの底部に発光チップが載置された発光素子全 体を、樹脂で封止してなる発光ダイオードであって、前 記樹脂は前記カップ内部を充填する第一の樹脂と、その 第一の樹脂を包囲する第二の樹脂とからなり、前記第一 の樹脂には発光チップの発光波長を他の波長に変換する 蛍光物質、または発光チップの発光波長を一部吸収する フィルター物質が含有されていることを特徴とする発光 ダイオード。

【請求項2】 前記第一の樹脂の樹脂に含まれる物質が 蛍光物質であって、前記第一の樹脂は前記カップの縁部 の水平面よりも低くなるように充填されていることを特 徴とする請求項1に記載の発光ダイオード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は発光ダイオード(以下し EDという。)に係り、特に発光チップの発光波長を異 なる波長に変換する、または発光チップの発光を一部吸 収するLEDに関する。

[0002]

【従来の技術】図2は従来のLEDの一構造を示す模式 断面図であり、1は化合物半導体よりなる発光チップ、 2はリードフレーム、3は発光チップの発光を発光観測 面側に反射させる目的で設けられたカップ、4は発光素 子全体を封止する樹脂である。通常、樹脂4は発光チッ プの発光を空気中に効率よく放出する目的で透明度の高 い樹脂が選択されるが、他にその発光チップの発光色を 変換する目的で、あるいは色を補正する目的で、その樹 脂4の中に発光チップの発光を他の波長に変換する蛍光 30 物質、または発光波長の発光波長を一部吸収するフィル ター物質5(以下、波長変換材料5という。)が混入さ れる場合がある。この場合、波長変換材料5は樹脂4に 均一に分散するように混入されるのが通常である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 目的で波長変換材料5を樹脂4中に均一に分散させる と、この図に示すように、波長変換された光、または不 要な波長がカットされた光は樹脂4中で四方八方に散乱 してしまい、集光が悪くなるという問題がある。図2の 矢印は発光チップの光が波長変換材料5にあたり、波長 変換された光が散乱する様子を模式的に示した図であ る。つまり、波長変換された光が散乱されることによ り、発光観測面側の光量が減少して輝度が低くなるので

【0004】また、波長変換材料5を蛍光物質に限定し た場合、新たな問題点として、異なる発光色のLEDを 接近して設置した際に、他のLED発光による蛍光物質 のよけいな発光の問題がある。例えば、青色発光チップ なる青色発光チップのみからなる青色LEDとを同一平 面上に水平に近接して並べた場合、緑色LEDを消灯し て、青色LEDを点灯すると、青色LEDから洩れ出る 光、つまり散乱する光により、緑色LEDの蛍光物質が 励起され、消灯した緑色LEDがあたかも点灯したよう な状態となり、両LEDの混色が発生する。

【0005】従って本発明の目的とするところは、LE Dの樹脂に波長変換材料を含有させて発光チップの波長 変換を行う際、まず変換された発光の集光をよくしてし EDの輝度を高めることを目的とし、また蛍光顔料を使 用した際、波長の異なるLEDを近接して設置しても混 色の起こらないLEDを提供することをもう一つの目的

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明のLEDは、発光 チップの発光を発光観測面側に反射するカップの底部に 発光チップが載置された発光素子全体を、樹脂で封止し てなるLEDであって、前記樹脂は前記カップ内部を充 填する第一の樹脂と、その第一の樹脂を包囲する第二の 樹脂とからなり、前記第一の樹脂には発光チップの発光 20 波長を他の波長に変換する蛍光物質、または発光チップ の発光波長を一部吸収するフィルター物質が含有されて いることを特徴とする。

[0007]

【作用】本発明のLEDは、発光チップの発光を第一の 樹脂内において所望の波長に変換、または不要な波長を 一部吸収する。このようにして波長変換された光は四方 八方に散乱するが、散乱した光のほとんどはカップによ り反射され、発光観測面側に集光される。つまり本願の カップは第一の樹脂内で波長変換材料により波長変換さ れた光を反射して集光できるので、変換光の集光効率が 格段に向上する。

【0008】さらに、波長変換材料を蛍光物質とした場 合、蛍光物質を含む第一の樹脂をカップの縁部の水平面 よりも低くなるように充填すると、外部から入射する光 がカップの縁で遮られ、蛍光物質にまで到達しないこと により、LED間の混色を防止することができる。簡単 にいうと、カップ深さを深くして蛍光物質を含む第一の 樹脂がカップからはみ出さないようにすることにより、 蛍光物質の励起源を発光チップの発光波長のみに制限で きる。

[0009]

【実施例】図1は本願の一実施例のLEDの構造を示す 模式断面図であり、図2と同様に、カップ3を有するリ ードフレーム2上に化合物半導体よりなる発光チップ1 を載置した発光累子全体を、樹脂で封止した構造として いる。しかし、図2と異なるところは、封止樹脂がカッ プ3内部を充填する第一の樹脂11と、その第一の樹脂 を包囲する第二の樹脂12とからなり、第一の樹脂11 で緑色発光が得られる蛍光物質を含む緑色LEDと、単 50 には発光チップの発光波長を他の波長に変換、または一 部吸収する変換する波長変換材料5が含有されている。 【0010】本発明のLEDにおいて、第一の樹脂11 と第二の樹脂の材料は同一材料でもよく、例えば両方と もエポキシ樹脂で構成し、第一の樹脂にのみ蛍光物質5 を含有させればよい。さらに、第二の樹脂12の材料は 図2の樹脂4と同一でもよいことはいうまでもない。ま た、波長変換材料5は蛍光物質であれば蛍光染料、蛍光 顔料、蛍光体等、発光チップの発光波長を他の波長に変 換できる材料であればどのようなものを使用してもよ く、またフィルター物質であれば発光チップの発光の不 10 要な波長を吸収し、色純度をよくする材料が選択され、 通常発光チップの発光色と同一色を有する無機、有機の フィルター顔料が使用される。

【0011】このような構造のLEDを得るには、例え ばLED製造工程において、通常カップ3の空気を追い 出す目的で、予め発光チップ1を載置したカップ内部を 樹脂でプレディップするのであるが、プレディップする 際に第一の樹脂11に波長変換材料5を含有させてお き、波長変換材料5を含む第一の樹脂11が硬化した 後、第二の樹脂12で封止することにより得ることがで きる。また予め波長変換材料5を含む第一の樹脂11を カップ3内部に注入してもよい。このようにして、波長 変換材料5を含む第一の樹脂11をカップの3の内部に 充填し、第一の樹脂11で波長変換された光のほとんど がカップ3の反射鏡内に戻り、発光観測面に反射するこ とによりLEDの集光が格段に向上する。

【0012】また第一の樹脂11と第二の樹脂12とを 異なる材料とし、第一の樹脂11、第二の樹脂12の屈 折率を順に小さくして空気の屈折率1に近くなるように 設定することにより波長変換された光の外部量子効率が 30 1・・・発光チップ 向上する。なおこの場合、第一の樹脂11の材料には、 発光チップ1の屈折率よりも小さい材料を選定すること は言うまでもない。

【0013】図3、および図4は本発明の他の実施例に 係るLEDのカップ3の部分を拡大して示す模式断面図 であり、図3は第一の樹脂11の表面が凸状になって硬 化してカップ3に充填された状態、図4は逆に凹状とな って硬化して充填された状態を示している。いずれの状 態においても、波長変換材料5を蛍光物質とした場合、 その蛍光物質を含む第一の樹脂11がカップ3の緑部の 水平面よりも低くなるように充填されており、カップ3 からはみ出していないので、カップ3の縁部により蛍光 物質を励起する外部光を遮断でき、LEDの混色を防止 することができる。

[0014]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のLEDは カップ内部に波長変換材料を含有する第一の樹脂を充填 しているため、変換光がカップ内部で反射して集光され るため、輝度は倍以上に向上する。また、蛍光顔料を第 一の樹脂に含有させて波長変換を行う場合、カップ深さ を深くして、第一の樹脂がカップからはみ出さないよう にすることにより、LED間の混色が発生せず、例えば 20 LEDで平面ディスプレイを実現した際には、非常に解 像度のよい画像を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

本発明の一LEDの構造を示す模式断面図。 【図1】

従来のLEDの構造を示す模式断面図。 【図2】

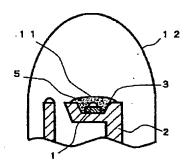
本発明の他の実施例に係るLEDのカップ3 【図3】 の部分を拡大して示す模式断面図。

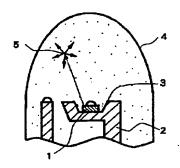
【図4】 本発明の他の実施例に係るLEDのカップ3 の部分を拡大して示す模式断面図。

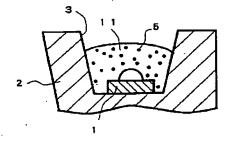
【符号の説明】

2・・・リードフレーム 3・・・カップ 5・・・波長変換材料 11・・・第一の樹脂 12・・・第二の樹脂

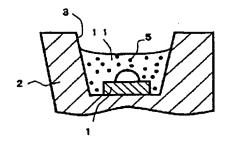
【図2】 【図1】 【図3】







【図4】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁶ H O 1 L 23/29

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

23/31